

Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu, care include doparea prin piroliză a compușilor precursori ai elementelor de pământuri rare sau metale de tranziție, caracterizat prin aceea că se impregnează un templat poros semiconductor cu o soluție apoasă a precursorilor menționați, după care templatul este supus unui tratament termic timp de o oră la o temperatură de până la 1200°C, într-o atmosferă formată din gaz inert cu adaos de oxigen.